



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20060728000B
2010 年 11 月 15 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA PCM180x/PCM4x04/VSP2582 製品 前処理サイト追加のご案内
(認定済 13 製品への追加認定 10 製品の連絡)

(第二版 PCN20060728000A 2006 年 8 月 28 日発行, 初版 PCN20060728000 2006 年 8 月 4 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	下記変更について認定済 13 製品への追加認定 10 製品の連絡になります。 HPA PCM180x/PCM4x04/VSP2582 製品 前処理サイト追加 現行 : TSMC-FAB3 社(台湾) 変更後 : TSMC-FAB3 社(台湾), TSMC-FAB9 社(台湾)			
対象製品	対象製品リスト参照。			
変更時期	追加認定品は 2011 年 2 月下旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2006 年 11 月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 今回のお知らせは、下記変更について認定済 13製品への追加認定 10製品の連絡になります。弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) HPA PCM180x/PCM4x04/VSP2582 製品の 前処理サイトについて、現行 TSMC-FAB3 社(台湾) サイトにて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TSMC-FAB9 社(台湾) サイトでの製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
前処理サイト	TSMC-FAB3 社(台湾)	TSMC-FAB3 社(台湾) TSMC-FAB9 社(台湾)

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
■:追加認定品 □:認定終了品				
HPA00331PFBT	PCM1803ADBRG4	PCM1807PW	PCM4104PFBT	PCM4204PAPT64
HPA00332PAPT	PCM1803DB	PCM1807PWR	PCM4104PFBTG4	VSP2582RHN
PCM1803ADB	PCM1803DBG4	PCM1807PWRG4	PCM4204PAPR	VSP2582RHNHR
PCM1803ADBG4	PCM1803DBR	PCM4104PFBR	PCM4204PAPRG4	
PCM1803ADBR	PCM1803DBRG4	PCM4104PFBRG4	PCM4204PAPT	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TSMC-WF3	TSMC-WF9
CSO (20L): 前処理サイト記号	TS5	TS9
CCO (21L): 生産国記号	TWN	TWN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	終了	2010年11月5日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	PCM1808PWR	-	-
Wafer Fab Site:	TSMC FAB9	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM
Die Protective Coating:	SiO2 ; SOG ; Si3N4	Metallization:	AlCu/TiN
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
Electrical Char.	per Datasheet parameters	Approved	
ESD - CDM	1500V	3/0	
ESD - HBM	4000V	3/0	
Latch-up	per JESD78	6/0	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	終了	2006年7月21日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	PCM1802DB	Die Size (mm)	3.93 x 2.30
Wafer Fab Site:	TSMC FAB9	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM Dual gate
Die Protective Coating:	SiO2/SiN,1.5/10kA	Metallization:	Al-Si-Cu
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	Notes
**HTOL	125C, 1000 hours	120/0	-
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	81/0	-
**High Temp. Storage Life	150C, 1000 hours	81/0	-
**Thermal Shock	-65/150C, 500 cycles	81/0	-
**Biased HAST	130C/85%, 96 hours	80/0	-
**Autoclave	121C, 96 hours	80/0	-
ESD - HBM	500V	3/0	-
ESD - HBM	1000V	3/0	-
ESD - HBM	1500V	3/0	-
ESD - HBM	2000V	3/1	(1)
ESD - CDM	500V	3/0	-
Latch-up	Current Injection 200mA	6/0	-
Latch-up	Over Voltage 1.5 x Vcc max	6/0	-
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C			
(1) There was no difference between Fab-9 and Fab-3 on PCM1802DB for ESD-HBM performance			

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2006年7月21日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	PCM1807PW	Die Size (mm)	1.75 x 2.13	
Wafer Fab Site:	TSMC FAB9	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM Dual gate	
Die Protective Coating:	SiO2/SiN, 1.5/10kA	Metallization:	Al-Si-Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	
**HTOL	125C, 1000 hours	120/0	120/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	84/0	84/0	
**High Temp. Storage Life	150C, 1000 hours	80/0	80/0	
**Thermal Shock	-65/150C, 500 cycles	80/0	80/0	
**Biased HAST	130C/85%, 96 hours	80/0	80/0	
**Autoclave	121C, 96 hours	80/0	80/0	
ESD - HBM	500V	3/0	3/0	
ESD - HBM	1000V	3/0	3/0	
ESD - HBM	1500V	3/0	3/0	
ESD - HBM	2000V	3/0	3/0	
ESD - CDM	500V	3/0	3/0	
Latch-up	Current Injection 200mA	6/0	6/0	
Latch-up	Over Voltage 1.5 x Vcc max	6/0	6/0	
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				